

# طراحی، شبیه‌سازی و ساخت سوئیچ خازنی RF MEMS بر روی بستر آلومینا

سعید دل آرام فریمانی<sup>۱</sup> حسن حاج قاسم<sup>۲</sup> علیرضا عرفانیان<sup>۳</sup> مجیدرضا علی احمدی<sup>۴</sup>

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد- دانشکده برق و الکترونیک-دانشگاه صنعتی مالک اشتر- تهران- ایران

[Saeed\\_delaram\\_mut@yahoo.com](mailto:Saeed_delaram_mut@yahoo.com)

۲- دانشیار- دانشکده علوم و فنون نوین - دانشگاه تهران- تهران- ایران

[Hhajghassem@yahoo.com](mailto:Hhajghassem@yahoo.com)

۳- استادیار- دانشکده برق و الکترونیک -دانشگاه صنعتی مالک اشتر- تهران- ایران

[Erfanian@mut.ac.ir](mailto:Erfanian@mut.ac.ir)

۴- مربی- دانشکده برق و الکترونیک -دانشگاه صنعتی مالک اشتر- تهران- ایران

[MR\\_aliahmadi@yahoo.com](mailto:MR_aliahmadi@yahoo.com)

**چکیده:** در این مقاله طراحی، شبیه‌سازی و ساخت یک سوئیچ خازنی RF MEMS موازی کم تلف بروی موجبر هم‌صفحه و بستر عایق آلومینا، در باند فرکانس ۴۰-۶۰ GHz ارائه شده است. مکانیزم تحریک این سوئیچ بصورت الکترواستاتیکی است. ابتدا موجبر هم‌صفحه برای داشتن امپدانس مشخصه  $50\Omega$  بروی بستر عایق آلومینا طراحی شده، سپس سوئیچ مورد نظر طراحی و پس از انتخاب ابعاد آن، پارامترهای مهم آن توسط شبیه‌سازی المان محدود و موجی کامل با نرم افزارهای CoventorWare و HFSS بدست آمده است. در این مقاله نشان داده شده که سوئیچ طراحی شده دارای عملکرد مناسبی در این باند فرکانسی است، بطوریکه ولتاژ پایین کشنده ۱۹/۲۵v، تلفات داخلی ۰/۸dB، تلفات بازگشتی بیشتر از ۹/۸dB و مقدار ایزولاسیون نیز ۵۰dB حاصل شده است. با توجه به ابعاد طراحی شده، نمونه آزمایشگاهی سوئیچ بروی بستر آلومینا ساخته شده که بر اساس اندازه‌گیری‌های صورت گرفته، مقدار تلفات داخلی ۲/۵dB و تلفات بازگشتی بیشتر از ۱۰dB حاصل شده است.

**کلمات کلیدی:** سوئیچ RF MEMS، موجبر هم‌صفحه، تحریک الکترواستاتیکی، تلفات داخلی، ایزولاسیون

تاریخ ارسال مقاله : ۱۳۹۱/۹/۷

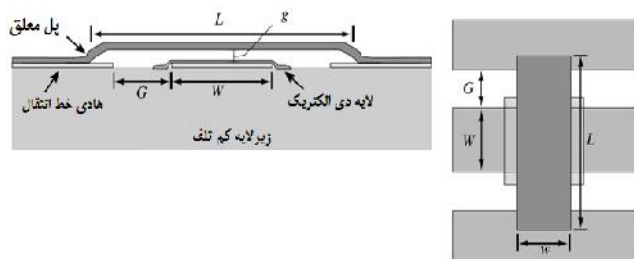
تاریخ پذیرش مشروط : ۱۳۹۳/۳/۱۲

تاریخ پذیرش مقاله : ۱۳۹۳/۷/۱۹

نام نویسنده مسئول: سعید دل آرام فریمانی

نشانی نویسنده مسئول: تهران، لویزان، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده برق و الکترونیک، صندوق پستی: ۱۷۷۴-۱۵۸۷۵

## ۱- مقدمه



شکل (۱): شماتیک یک سوئیچ RF MEMS

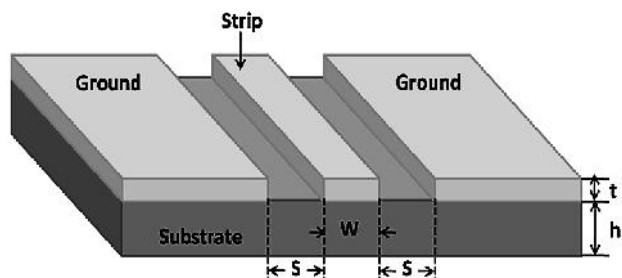
روش‌های مختلفی برای بررسی این ساختار وجود دارد. در مرجع [۳] مدل پارامتری عناصر فشرده برای یک سوئیچ خازنی، بر پایه تحلیل موجی کامل با شبیه ساز HFSS و با شرایط مرزی تشعشی و هادی کامل ارائه شده است. بدست آوردن مقدار عناصر فشرده تشکیل دهنده سوئیچ و استخراج پارامترهای S با روش‌های عددی نیز در منبع [۴] بیان شده است. اما در اینجا پارامترهای RF مورد نظر با استفاده از شبیه‌سازی موجی کامل توسط نرم‌افزار HFSS ارائه گردیده است. از شبیه‌سازی المان محدود توسط نرم‌افزار CoventorWare نیز برای بدست آوردن پارامترهای مکانیکی سوئیچ مورد نظر استفاده شده است.

نوعاً از سیلیکون با مقاومت بالا بعنوان بستر کم تلف استفاده می‌شود [۵]. در مرجع [۶]، پارامترهای سوئیچ بروی بستر سیلیکون مقاومت بالا، سیلیکون متخلخل و کوارتز با یکدیگر مقایسه شده است. اما در تحقیق از بستر عایق آلومینا استفاده شده است. در این مقاله ابتدا یک موجبر هم‌صفحه با امپدانس مشخصه ۵۰ اهم طراحی شده، سپس یک سوئیچ MEMS بر روی موجبر هم‌صفحه طراحی گردیده و تحلیل‌های الکترومکانیکی، گذرا و موجی آن توسط نرم افزارهای CoventorWare و HFSS انجام شده است.

## ۲- موجبر هم‌صفحه

موجبر هم‌صفحه یک خط انتقال یک طرفه با سه هادی رسانا بروی یک بستر عایق است. موجبر هم‌صفحه شامل دو صفحه زمین و یک هادی مرکزی است که در وسط قرار می‌گیرد، همانطور که در شکل (۲) دیده می‌شود. این موجبرها، اثرات تزویج خازنی را کاهش داده و اجازه اتصال المان‌ها را می‌دهند. موجبرهای هم‌صفحه بطور عمده برای عناصر مداری و خطوط متصل بهم استفاده می‌شوند.

سوئیچ قطعه‌ای ساده اما ضروری در سیستم‌های مخابراتی، رادار، اندازه گیری و کنترل می‌باشد و بعنوان وسیله‌ای برای برقراری اتصال یا قطع یک مدار الکتریکی تعریف می‌شود. در حالت‌های مختلف بویژه در فرکانس‌های بالا تحلیل عملکرد سوئیچ مستلزم محاسبات طولانی و پیچیده است. بسته به نوع سوئیچ، توصیف آن مستلزم بررسی مفاهیمی از فیزیک، مکانیک و الکترومغناطیس بطور همزمان می‌باشد. کاربرد سیستم‌های میکروالکترومکانیکی (MEMS) در آرایه‌های فازی آنتن‌های میکرواستریپ و بطور عام در مهندسی آنتن و مایکروویو افزایش چشمگیری داشته و در سال‌های اخیر توجه محققان و مهندسان را به خود معطوف کرده است. در این میان سوئیچ بعنوان بلوک اصلی اهمیت ویژه‌ای دارد. تلفات داخلی پائین؛ ایزولاسیون بالا؛ اعوجاج مدولاسیون داخلی پائین در اثر خاصیت خطی قوی؛ وزن و حجم و هزینه ساخت کم و نیز سازگاری با فناوری MMIC و مزایای عمده این سوئیچ‌ها نسبت به سوئیچ‌های نیمه هادی FET و دیوده‌های P-I-N می‌باشند. البته سرعت سوئیچینگ پائین و ولتاژ بایاس بالا از جمله معایب این سوئیچ‌هاست [۱]. سوئیچ موازی بر روی موجبر هم‌صفحه (CPW) معروفترین و پرکاربردترین سوئیچ MEMS محسوب می‌شود. ساختمان فیزیکی این نوع سوئیچ در شکل (۱) دیده می‌شود که از یک لایه نازک فلزی بصورت معلق بر روی هادی مرکزی همانند پل که در طرفین به هادی‌های کناری متصل گردیده تشکیل شده است [۲]. بدون ولتاژ بایاس پل با فاصله زیاد از هادی مرکزی قرار داشته و سیگنال توسط خط انتقال می‌یابد. با اعمال ولتاژ بایاس در اثر نیروی الکترواستاتیکی، پل پایین کشیده شده و خازنی بزرگ روی خط سیگنال تشکیل شده که سیگنال ac را بطرف زمین اتصال کوتاه می‌کند. بدین ترتیب حالت‌های روشن و خاموش سوئیچ ایجاد می‌گردد. برای جلوگیری از اتصال پل فلزی به خط سیگنال، یک لایه دی الکتریک روی هادی مرکزی خط قرار داده می‌شود. پهنای فاصله و جنس هادی‌های موجبر هم‌صفحه و ضخامت و جنس بستر و همچنین جنس، طول، پهنای و ضخامت پل معلق در عملکرد سوئیچ مؤثرند. همچنانکه در شکل (۱) دیده می‌شود، ساختار این سوئیچ از موادی با جنس‌های متفاوت با شرایط مرزی پیچیده تشکیل شده است.



شکل (۲): شماتیک موجبر هم صفحه

ایجاد تلفات می گردند. به همین دلیل، زیر هادی های موجبر یک لایه بافر قرار می دهند [۹]. بدین ترتیب یک خازن پارازیتی ایجاد شده که در فرکانس های بالا خود باعث تلفات می شود. پس بهتر است لایه بافر، ثابت دی الکتریک کمتر و ضخامت بیشتری داشته باشد تا بدین ترتیب مقدار این خازن پارازیتی کاهش یابد. اما در اینجا از بستر عایق استفاده شده است، در نتیجه خازن پارازیتی مورد اشاره ایجاد نخواهد شد.

### ۳- سوئیچ RF MEMS

سوئیچ موردنظر از نوع سوئیچ خازنی است که بصورت موازی در مدار قرار می گیرد. این سوئیچ همان طور که در شکل (۱) نیز دیده می شود روی موجبر هم صفحه قرار گرفته و شامل دو الکتروود است. الکتروود پائین همان خط انتقال مرکزی موجبر هم صفحه می باشد و الکتروود بالایی یک باریکه نازک فلزی است که بصورت معلق بر روی الکتروود پایینی قرار گرفته و از طرفین به هادی های کناری موجبر هم صفحه متصل می باشد. یک لایه نازک دی الکتریک نیز جهت جلوگیری از اتصال فلز به فلز، بر روی الکتروود پائین پوشانده می شود. در اینصورت هم از چسبیدن ناخواسته الکتروودها جلوگیری کرده و هم خازنی تشکیل می دهد که موجب عملکرد مناسب سوئیچ در فرکانس های بالاتر از ۱۰ GHz می شود. باریکه می تواند بین دو موقعیت بالا و پایین با اعمال یک ولتاژ تحریک DC تغییر وضعیت دهد. هنگامیکه هیچ ولتاژ تحریکی اعمال نشود، باریکه به شکل یک خازن کوچک پارازیتی ظاهر خواهد شد که در حالت ایده آل می توان از آن صرف نظر نمود. در اینصورت سوئیچ در حالت روشن قرار دارد (باریکه در موقعیت بالا). با اعمال ولتاژ DC به خط انتقال مرکزی، در اثر نیروی الکترواستاتیکی باریکه به پائین کشیده شده و به لایه دی الکتریک می چسبد. در این موقعیت ظرفیت خازنی خیلی زیادی (امپدانس کمی) ایجاد می شود. در اینصورت سوئیچ در حالت خاموش قرار دارد (باریکه در موقعیت پایین). با قطع ولتاژ بایاس، در اثر خاصیت کشسانی، باریکه به حالت اولیه باز می گردد.

### ۳-۱- طراحی ابعاد سوئیچ

با در نظر گرفتن ابعاد طراحی شده برای موجبر هم صفحه  $W+2S=380 \mu\text{m}$  می باشد. پس طول باریکه سوئیچ،  $l=380 \mu\text{m}$  انتخاب می شود. جنس باریکه از آلومینیوم انتخاب شده، چراکه علاوه بر داشتن رسانندگی الکتریکی مناسب (S/m)  $3.75 \times 10^7$ ، مازول یانگ نسبتاً پایینی دارد ( $E=70 \text{ GPa}$ ). در

ساختار موجبر هم صفحه از مد انتشار شبه TEM پیروی می کند و چندین مزیت نسبت به خطوط میکرواستریپ مرسوم دارد، از جمله: ساخت آسان تر؛ پیاده سازی آسان قطعات فعال و غیرفعال بصورت موازی؛ کاهش تلفات تابشی و اینکه نیازی به کمر بند جانبی و سوراخ های اتصال ندارد [۷].

### ۲-۱- طراحی موجبر هم صفحه

در یک موجبر هم صفحه ایده آل، ضخامت بستر عایق بینهایت است. البته در عمل این ضخامت باید باندازه کافی بزرگ باشد تا میدان مغناطیسی قبل از آنکه از آن خارج شود، از بین برود. امپدانس مشخصه این موجبر هم صفحه از رابطه زیر بدست می آید [۸]:

$$Z_0 = \frac{30\pi^2}{\sqrt{(\epsilon_r + 1)/2}} \left[ \text{Ln} \left( 2 \frac{1 + \sqrt{K}}{1 - \sqrt{K}} \right) \right] \quad (1)$$

$$K = \frac{W}{W + 2S} \quad (2)$$

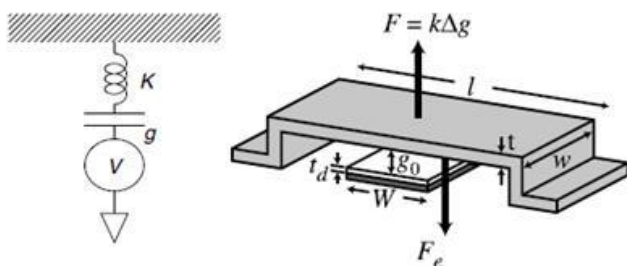
که  $W$  عرض خط مرکزی و  $S$  عرض شکاف و  $\epsilon_r$  ضریب دی الکتریک نسبی بستر است. در طراحی موجبر هم صفحه، بستر از جنس آلومینا با  $\epsilon_r = 9/8$  و  $\text{Loss Tangent} = 0.005$  و ضخامت  $h = 50 \mu\text{m}$  و هادی ها از جنس طلا با رسانندگی S/m  $4.1 \times 10^7$  و ضخامت  $t = 1 \mu\text{m}$  است. در اینصورت می توان از سونش مرطوب برای سونش لایه دی الکتریک روی هادی مرکزی (اکسید سیلیکون) استفاده کرد، چراکه سونش گر اکسید سیلیکون (بافر هیدروفلوریک اسید) آسیبی به لایه طلا نمی رساند. ابعاد موجبر هم صفحه برای داشتن بهترین تطبیق امپدانس ( $50 \Omega$ ) توسط نرم افزار HFSS بصورت  $W = 150 \mu\text{m}$  و  $S = 115 \mu\text{m}$  بدست آمد. در اینصورت موجبر دارای تطبیق امپدانس مناسب در ورودی و خروجی بوده و میزان تلفات خط حداقل خواهد شد. در بسیاری از طراحی ها از سیلیکون با مقاومت بالا (ناخالصی کم)، در حدود  $5-10 \text{ K}\Omega \cdot \text{cm}$  استفاده می شود. ولی بدلیل اینکه سیلیکون بستر عایق کامل نیست، در هنگام بایاس dc، جریان های ناشی بین خط سیگنال و خط زمین جاری می شوند و باعث

جدول (۲): ابعاد سوئیچ طراحی شده

پارامتر	اندازه (μm)	پارامتر	اندازه (μm)
h	۵۰۰	W	۱۰۰
W	۱۵۰	g <sub>0</sub>	۳
S	۱۱۵	T	۱
L	۳۸۰	t <sub>d</sub>	۰/۳

### ۲-۲- تحلیل الکترواستاتیکی سوئیچ

یک سوئیچ موازی مطابق با شکل (۳) در نظر بگیرید. این سوئیچ با دو خازن سری و یک فنر که به صورت سری با خازن قرار دارد، مدل می‌شود. با این روش ولتاژ تحریک بر حسب انحراف پل معلق سوئیچ محاسبه شده و ولتاژ پایین‌کننده<sup>۲</sup> و ولتاژ پایین‌نگه‌دارنده<sup>۴</sup> بدست می‌آید. در معادلات ارائه شده  $A=w.W$ ، مساحت الکتروود است که  $W$  عرض پل و  $w$  عرض هادی مرکزی موجب هم‌صفحه می‌باشد،  $g_0$  فاصله پل از روی الکتروود در بایاس صفر،  $\Delta$  میزان انحراف پل،  $k$  ثابت فنر باریکه و  $\epsilon_r$  ثابت دی‌الکتریک لایه عایق است.



شکل (۳): شماتیک سوئیچ و مدل مکانیکی آن

از آنجا که ظرفیت معادل خازن‌ها برابر است با:

$$C = \frac{1}{\frac{1}{C_{air}} + \frac{1}{C_d}} = \frac{\epsilon_0 w W}{g_0 - \Delta + \frac{t_d}{\epsilon_r}} \quad (3)$$

پس نیروی الکترواستاتیکی بین صفحات طبق رابطه زیر می‌باشد:

$$F_{el} = \frac{\epsilon_0 w W V^2}{2(g_0 - \Delta + \frac{t_d}{\epsilon_r})} \quad (4)$$

همچنین نیروی فنری بازگرداننده پل نیز برابر است با:

$$F_m = k\Delta \quad (5)$$

وقتی دو نیرو در حال تعادل باشند، رابطه زیر برقرار است:

$$F_{el} = \frac{\epsilon_0 w W V^2}{2(g_0 - \Delta + \frac{t_d}{\epsilon_r})} = k\Delta \quad (6)$$

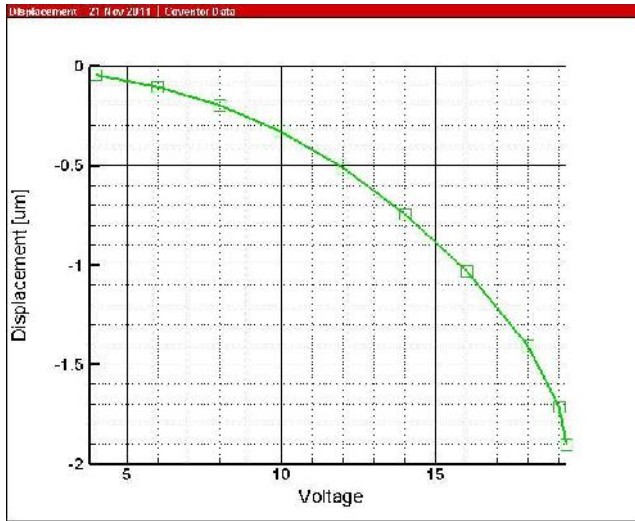
با توجه به رابطه (۶) ولتاژ تحریک بر حسب انحراف پل معلق  $\Delta$  به صورت زیر خواهد بود:

نتیجه ثابت فنر باریکه معلق کمتر شده و ولتاژ تحریک، کاهش می‌یابد. ضخامت باریکه سوئیچ با توجه به عمق پوستی آلومینیوم که در جدول (۱) آورده شده است انتخاب می‌گردد.

جدول (۱): عمق پوستی آلومینیوم [۷]

فرکانس (GHz)	۱۰	۲۵	۴۰
عمق پوستی (μm)	۰/۸۲	۰/۵۲	۰/۴

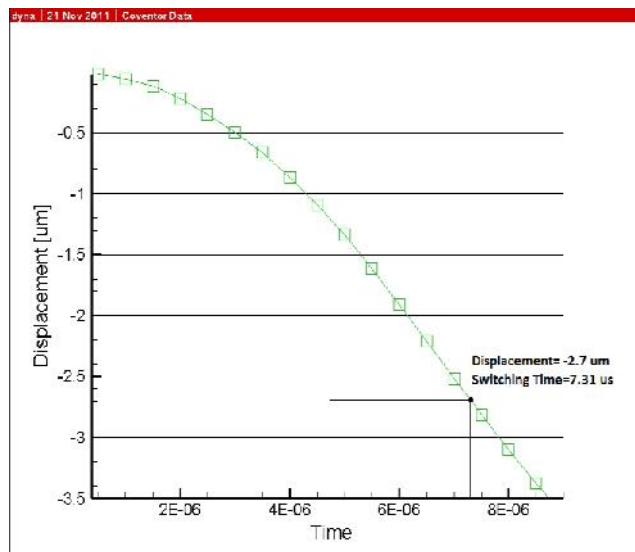
دیده می‌شود عمق پوستی آلومینیوم در فرکانس ۱۰ GHz،  $\delta = 0.82 \mu m$  است. پس ضخامت باریکه برای عملکرد مناسب در فرکانس‌های کمتر از ۱۰ GHz، حداقل  $t = 1 \mu m$  باید باشد. فاصله هوایی بین دو الکتروود (پل معلق و خط انتقال مرکزی)،  $g_0$  هم در میزان تلفات و هم در مقدار ولتاژ تحریک مؤثر است. افزایش این پارامتر از طرفی باعث پایین آمدن تلفات شده و از طرفی دیگر ولتاژ تحریک را افزایش می‌دهد. با مصالحه بین این دو، مقدار فاصله هوایی  $g_0 = 3 \mu m$  برگزیده می‌شود. برای انتخاب پهنای پل نیز، افزایش آن موجب بزرگتر شدن ثابت فنر پل شده و از طرف دیگر مساحت مؤثر تحریک را هم افزایش می‌دهد، پس در مقدار ولتاژ تحریک اثری ندارد [۱۰]. ولی مقدار خازن‌های حالت روشن و خاموش را تغییر داده بطوریکه کاهش پهنای باریکه موجب کاهش خازن پارازیتی ایجاد شده در حالت سوئیچ روشن شده و تلفات را کاهش می‌دهد، ولی مقدار ایزولاسیون در حالت سوئیچ خاموش نیز کاهش می‌یابد. بنابراین عرض باریکه  $w = 100 \mu m$  انتخاب می‌شود. لایه دی‌الکتریک روی هادی مرکزی، اکسید سیلیکون با ضریب دی‌الکتریک  $\epsilon_r = 3/9$  برگزیده شد تا بتوان از فرآیند سونش مرطوب (استفاده از هیدروفلوئوریک اسید (HF)) در ساخت سوئیچ استفاده کرد. در اینصورت نیازی به استفاده از تجهیزات گران قیمت سونش خشک نخواهد بود. هرچه ضخامت لایه دی‌الکتریک کمتر یا ثابت دی‌الکتریک بالاتر باشد، عملکرد سوئیچ بهتر است. ولی در کاهش مقدار ضخامت محدودیت وجود دارد. با توجه به محدودیت‌های موجود در پیاده‌سازی، میزان سختی و مشخصات لایه دی‌الکتریک، کمترین ضخامت لایه دی‌الکتریک حدود  $100 \text{ nm}$  است [۸]. اکسید سیلیکون به روش تبخیر توسط باریکه الکترونی لایه نشانی خواهد شد. بنابراین ضخامت لایه عایق  $t_d = 300 \text{ nm}$  انتخاب می‌شود، تا ظرفیت خازنی مناسبی در حالتی که باریکه سوئیچ پایین است، بدست آید. ابعاد طراحی شده در جدول (۲) آورده شده است.



شکل (۵): جابجایی باریکه بر حسب ولتاژ اعمالی

### ۳-۳- تحلیل گذرای سوئیچ

زمان سوئیچینگ از پارامترهای مهم یک سوئیچ RF MEMS است و به مدت زمانی که طول می کشد تا پس از اعمال ولتاژ تحریک سوئیچ تغییر وضعیت دهد، اطلاق می شود. این پارامتر بیانگر سرعت سوئیچ نیز می باشد. زمان سوئیچینگ باید تا حد امکان کوچک باشد تا سرعت سوئیچینگ افزایش یابد. برای سوئیچ های میکروالکترومکانیکی، بدلیل وجود اینرسی در سازه مکانیکی سوئیچ، این زمان از مرتبه میکرو ثانیه (۳۰۰-۱) است. درحالیکه برای سوئیچ های نیمه هادی، این زمان از مرتبه نانو ثانیه (۱-۱۰ ns) می باشد. به همین دلیل زمان سوئیچینگ بیشتر، یکی از معایب سوئیچ های میکروالکترومکانیکی محسوب می شود [۱۰]. سوئیچ مورد نظر در نرم افزار CoventorWare تحلیل گذرا شده و نتیجه در شکل (۶) آورده شده است.



شکل (۶): جابجایی باریکه سوئیچ بر حسب زمان در ولتاژ ۲۰ ولت

$$V = (g_0 - \Delta + t_d / \epsilon_r) \sqrt{\frac{2k\Delta}{\epsilon_0 w W}} \quad (7)$$

ولتاژ پایین کشنده، ولتاژی است که در آن باریکه به اندازه دو سوم فاصله هوایی پایین می آید. در این فاصله افزایش نیروی الکترواستاتیکی بیشتر از افزایش نیروی بازگرداننده است. در نتیجه در این فاصله وضعیت باریکه ناپایدار شده و باریکه به پایین سقوط می کند. بنابراین:

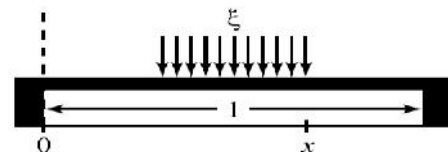
$$V_{PI} = \left(\frac{2}{3} g_0 + \frac{t_d}{\epsilon_r}\right) \sqrt{\frac{2k g_0}{3 \epsilon_0 w W}} \cong \sqrt{\frac{8k g_0^3}{27 \epsilon_0 w W}} \quad (8)$$

ولتاژ پایین نگه دارنده نیز حداقل ولتاژی است که پل را در موقعیت پایین نگه می دارد:

$$V_h = V(\Delta = g_0) = \left(\frac{t_d}{\epsilon_r}\right) \sqrt{\frac{2k g_0}{\epsilon_0 w W}} \quad (9)$$

در باریکه سوئیچ که از دو طرف ثابت شده است، اگر نیرو به یک سوم میانی اعمال شود (شکل (۴))، ثابت فنر برابر است با [۱۰]:

$$k = 32 E w \left(\frac{t}{l}\right)^3 \quad (10)$$



شکل (۴): اعمال نیرو به یک سوم میانی باریکه سوئیچ

بنابراین ثابت فنر سازه سوئیچ، با استفاده از رابطه (۱۰) برابر  $k = 3/26 N/m$  می شود. از اینرو، ولتاژ پایین کشنده طبق رابطه (۸)  $V_{PI} = 19/19 V$  بدست می آید. سوئیچ در نرم افزار CoventorWare، با استفاده از روش المان محدود، تحلیل الکترومکانیکی گردید. نتیجه در شکل (۵) نشان داده است. همانطور که در این شکل دیده می شود در ولتاژ حدود  $V_{PI} = 19/25 V$  جابجایی باریکه سوئیچ حدود  $\Delta = 2 \mu m$  (دو سوم فاصله هوایی) است. بنابراین، ولتاژ پایین کشنده سوئیچ  $V_{PI} = 19/25 V$  بدست می آید.

مشاهده می‌شود که زمان لازم برای جابجایی  $\Delta = 2/7 \mu\text{m}$  در ولتاژ تحریک  $V = 20 \text{ V}$ ،  $t = 7/31 \mu\text{s}$  است. این زمان برای یک سوئیچ RF MEMS، زمان کمی است، در نتیجه سرعت سوئیچینگ مناسب خواهد بود.

### ۳-۴- تحلیل موجی سوئیچ

پارامترهای مهم در تحلیل یک سوئیچ RF MEMS، تلفات داخلی، ایزولاسیون و ولتاژ تحریک هستند. در بخش قبل ولتاژ تحریک با استفاده از تحلیل همزمان الکترومکانیکی با نرم‌افزار CoventorWare و نیز از طریق محاسبه، بدست آمد. برای بدست آوردن پارامترها باقی مانده، از تحلیل موجی سوئیچ استفاده می‌شود. برای این منظور ساختار سوئیچ در دو حالت سوئیچ در وضعیت روشن (باریکه در موقعیت بالا) و سوئیچ در وضعیت خاموش (باریکه در موقعیت پایین) در نرم افزار HFSS شبیه سازی و نتایج بدست آمده تحلیل گردید.

نرم‌افزار HFSS، روش المان محدود را بکار گرفته و فضای مورد نظر را به چهار وجهی‌های متعددی تقسیم نموده و میدان‌ها را در هر سلول تقریب می‌زند. معادلات موج برای میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی بطور مستقل حل گردیده و نتایج در معادلات ماکسول زیر آزمایش می‌شود:

$$\nabla \times \vec{H} = \sigma \vec{E} + j\omega \epsilon \vec{E} \quad (11)$$

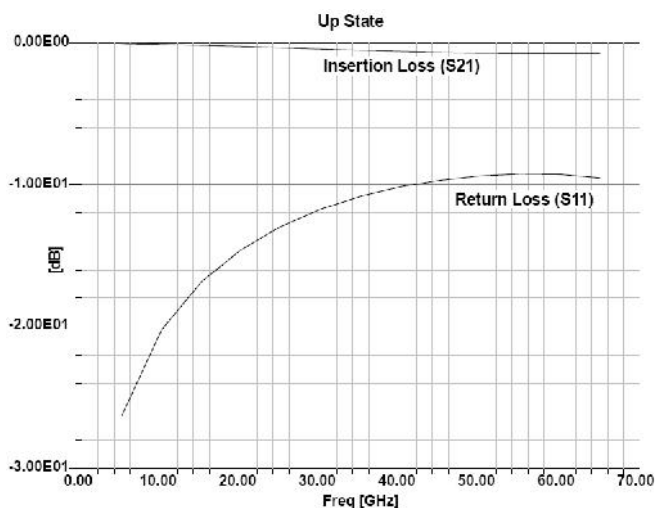
$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega \mu \vec{H} \quad (12)$$

در صورت قابل قبول بودن نتایج، میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی مورد نظر بدست می‌آید. روش کار در HFSS با شبکه‌بندی تمام فضای مورد نظر با چهار وجهی شروع می‌شود. شبکه بندی اولیه با توجه به دقت در گام‌های بعدی بصورت بهینه قابل تصحیح است. با استفاده از مقادیر میدان‌ها پارامترهای S بدست می‌آیند. روش‌های تحلیل موجی هم‌صفحه عمدتاً در مد TEM و به کمک نگاشت همدیس بوده و منجر به رابطه‌های تجربی می‌گردد که بستگی فرکانسی در آن‌ها منظور نشده و ضخامت هادی‌ها یکسان فرض می‌شود [۱۱ و ۱۲].

### ۳-۴-۱- سوئیچ در وضعیت روشن (باریکه در موقعیت بالا)

همانطور که اشاره شد، در صورتیکه ولتاژ تحریکی اعمال نشود، پل به شکل یک خازن کوچک پارازیتی (از مرتبه fF) ظاهر می‌شود که در حالت ایده‌آل می‌توان از آن صرف‌نظر نمود. در اینصورت سوئیچ در حالت روشن قرار دارد. سوئیچ در رنج فرکانسی ۰-۶۵ GHz شبیه‌سازی شده و پارامترهای S آن

استخراج گردید. همانطور که در شکل (۷) دیده می‌شود، تلفات داخلی ( $S_{11}$ -) در حالت سوئیچ روشن) بین ۰dB و ۰/۸dB و تلفات بازگشتی ( $S_{11}$ -) نیز بین ۲۶dB و ۹/۵dB تغییر می‌کند.



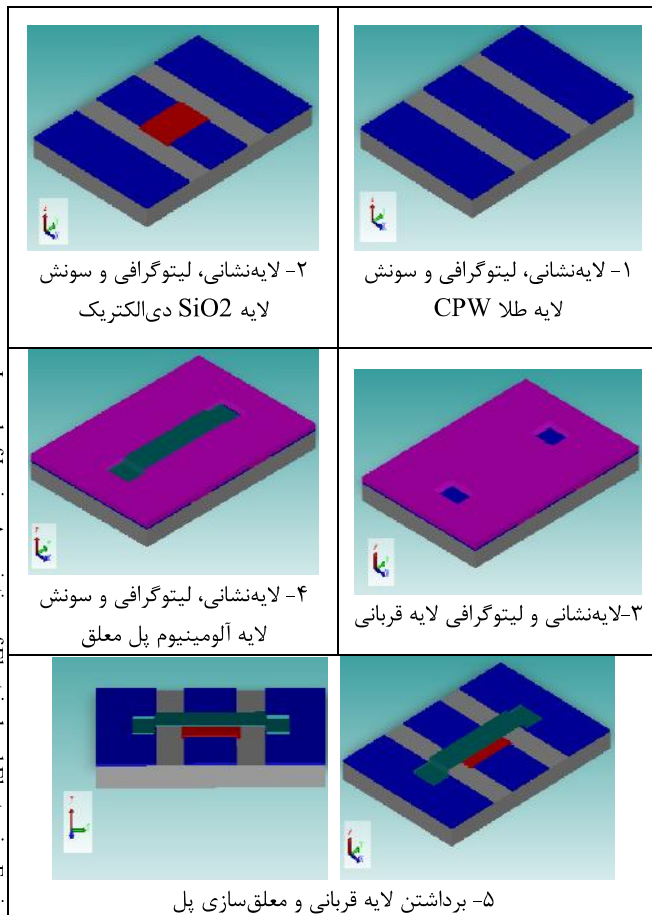
شکل (۷): پارامترهای سوئیچ در وضعیت روشن

با نگاهی به مقدار تلفات داخلی، دیده می‌شود که تلفات پایین است و بیشتر سیگنال از خط انتقال عبور می‌کند. تلفات بازگشتی نیز حاصل بوجود آمدن خازن پارازیتی، بدلیل نزدیکی مسیر سیگنال به باریکه زمین شده معلق روی آن است [۱۳]. مقدار این خازن (خازن حالت بالا) با استفاده از رابطه (۵) برابر  $C_u = 23/01 \text{ fF}$  بدست می‌آید. هرچه فرکانس افزایش یابد، مقدار تلفات بازگشتی کم می‌شود، بطوریکه در فرکانس ۶۵GHz به مقدار ۹/۸dB می‌رسد. این بدین معناست که در فرکانس‌ها بالاتر دامنه سیگنال بازگشتی بزرگتر می‌شود (بدلیل اینکه تلفات بازگشتی کمتر شده است). با توجه به مقادیر بدست آمده از تحلیل موجی سوئیچ در وضعیت روشن، می‌توان نتیجه گرفت که سوئیچ عملکرد خوبی در باند فرکانسی ۴۰-۶۰ GHz از خود نشان می‌دهد، چراکه در این باند فرکانسی تلفات داخلی در حدود ۰/۸dB است.

### ۳-۴-۲- سوئیچ در وضعیت خاموش (باریکه در موقعیت پایین)

با اعمال ولتاژ به خط انتقال مرکزی، در اثر نیروی الکترواستاتیکی باریکه به پائین کشیده شده و به لایه دی-الکتریک می‌چسبد. در اینصورت سوئیچ در حالت خاموش قرار گرفته و ظرفیت خازنی خیلی زیادی (از مرتبه pF) ایجاد می‌شود. سوئیچ در وضعیت روشن بصورت پلکانی مدل شده و در رنج فرکانسی ۰-۶۵ GHz شبیه‌سازی گردید و پارامترهای S آن

فرآیند ساخت با لایه‌نشانی طلا بعنوان فلز لایه موجبرهم- صفحه آغاز می‌شود. برای این منظور لایه طلا به ضخامت  $1\mu\text{m}$  به روش تبخیر حرارتی لایه‌نشانی می‌گردد. سپس با ماسک مربوط به موجبرهم صفحه لیتوگرافی نوری شده و در محلول  $\text{KI:I}_2:\text{H}_2\text{O}$  سونش می‌شود (مرحله اول). بعد از آن یک لایه نازک اکسید سیلیکون ( $\text{SiO}_2$ ) به ضخامت  $300\text{nm}$  بعنوان لایه دی‌الکتریک روی هادی مرکزی، با روش تبخیر حرارتی توسط پرتوی الکترون لایه‌نشانی، و سپس با ماسک مربوط به لایه دی-الکتریک، لیتوگرافی نوری شده و در محلول بافر هیدروفلوریک اسید (BHF) سونش می‌گردد (مرحله دوم). گام بعدی، لایه-نشانی لایه قربانی است. لایه قربانی برای معلق سازی سازه‌ها ضروری است. این لایه بعد از اینکه ساختار معلق شکل گرفت، برداشته می‌شود. مواد مختلفی بعنوان لایه قربانی استفاده می-شوند، از جمله اکسید سیلیکون، پلی سیلیکون و بسیاری از فوتورزیست‌ها.



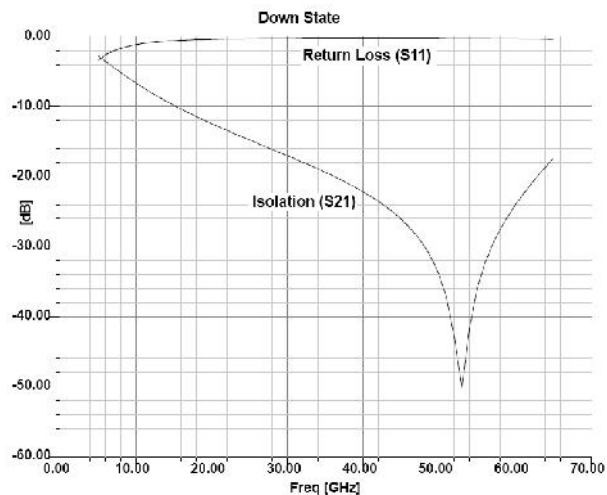
شکل (۹): شماتیک مراحل ساخت سوئیچ RF MEMS مورد نظر

در اینجا از فوتورزیست مثبت شیپلی ۱۸۱۳ بعنوان ماده قربانی استفاده شده است. دو مرحله فوتورزیست توسط لایه-نشانی چرخشی لایه‌نشانی و پخت داده شد، تا ضخامت لایه

بدست آمد. نتیجه شبیه‌سازی در شکل (۸) آورده شده است. دیده می‌شود ایزولاسیون ( $S_{11}$  - در حالت سوئیچ خاموش) در فرکانس‌های  $40-60\text{GHz}$  مقدار مناسبی دارد (بیشتر از  $24\text{dB}$ )، و در محدوده فرکانس  $53\text{GHz}$  بهترین ایزولاسیون (حدود  $50\text{dB}$ ) بدست می‌آید. در فرکانس‌های پایین‌تر، ایزولاسیون توسط ظرفیت خازنی بزرگ ایجاد شده (خازن حالت پایین) تعیین می‌شود. مقدار خازن برابر

$$C_d = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r w W}{t_d} = 0.92\text{pF}$$

است. در فرکانس‌های بالاتر این خازن از نظر مداری اتصال کوتاه شده و مقاومت سری مؤثر سوئیچ، تعیین کننده مقدار ایزولاسیون است [۱۳]. تلفات بازگشتی ( $S_{11}$  -) هم در این حالت با افزایش فرکانس کاهش می‌یابد، که در فرکانس‌های بالاتر از  $20\text{GHz}$  تقریباً صفر است.

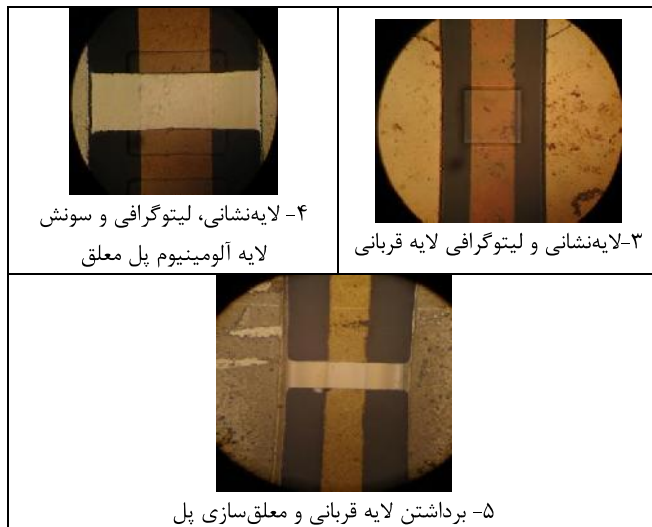


شکل (۸): پارامترهای سوئیچ در وضعیت خاموش

بنابراین سوئیچ در وضعیت خاموش نیز عملکرد بسیار خوبی در باند فرکانسی  $40-60\text{GHz}$  دارد، چراکه در این باند ایزولاسیون بیشتر از  $24\text{dB}$  و تلفات بازگشتی بسیار ناچیز است.

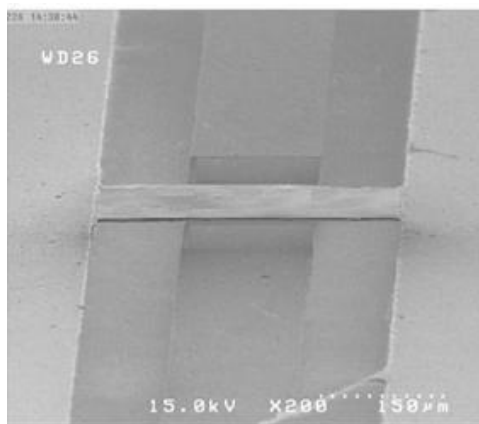
#### ۴- ساخت سوئیچ و اندازه‌گیری پارامترهای آن

پس از طراحی و شبیه‌سازی، سوئیچ RF MEMS مورد نظر با استفاده از روش میکروماشین کاری سطحی ساخته شد. برای این منظور پروسه‌ای با ۴ ماسک (حداقل تعداد ممکن برای ساخت سوئیچ) طراحی گردید. سوئیچ مورد نظر بروی بستر عایق آلومینا ساخته شد تا تلفات زیرلایه در فرکانس‌های رادیویی از بین رفته و ساختار از طریق بستر، اتصال اهمی نداشته باشد. شماتیک پروسه ساخت در ۵ مرحله اصلی در جدول (۳) آورده شده است.



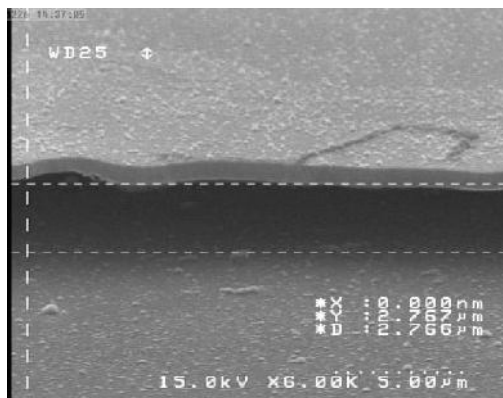
شکل (۱۰): تصاویر مراحل ساخت سوئیچ RF MEMS مورد نظر

در شکل (۱۱) نیز تصویر میکروسکوپ پویش الکترونی نمونه آزمایشگاهی ساخته شده آورده شده است.



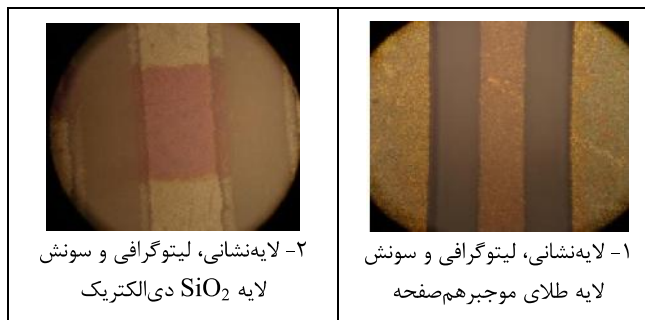
شکل (۱۱): تصویر میکروسکوپ پویش الکترونی سوئیچ RF MEMS

مطابق شکل (۱۲) دیده می شود که فاصله هوایی بوجود آمده حدود  $2/767\text{nm}$  بوده، که نزدیک مقدار طراحی شده است.



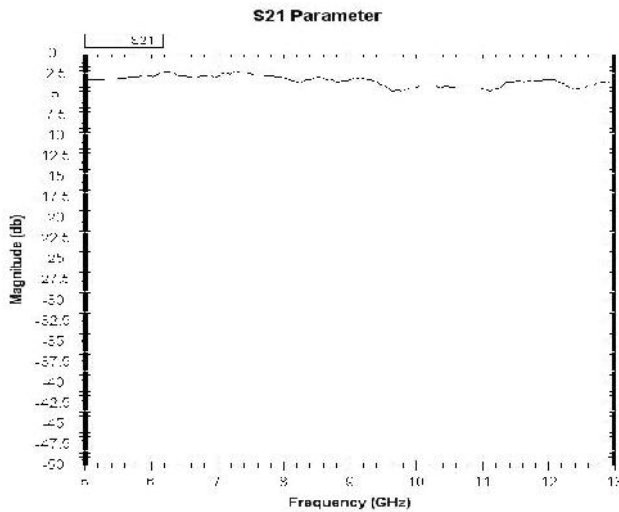
شکل (۱۲): فاصله هوایی ایجاد شده زیر پل معلق

قربانی به مقدار مورد نظر ( $3\mu\text{m}$ ) نزدیک تر شود. پس از لایه-نشانی لایه قربانی، این لایه توسط ماسک پایه‌ها لیتوگرافی نوری می شود (مرحله سوم). بعد از آن یک لایه آلومینیوم به ضخامت  $1\mu\text{m}$ ، بعنوان لایه پل معلق، با روش تبخیر حرارتی توسط پرتوی الکترونی، لایه نشانی می گردد. در این مرحله باید دقت شود که دمای نمونه‌ها در حین لایه‌نشانی از حدود  $100^\circ\text{C}$  بالاتر نرود، چراکه به دلیل وجود فوتورزسیست (بعنوان لایه قربانی) دمای بالاتر از این مقدار می تواند موجب آسیب دیدن فوتورزسیست شود که مطلوب نیست. سپس با استفاده از ماسک مربوط به پل معلق، این لایه لیتوگرافی نوری شده و در محلول سونش گر اسید فسفریک (۱:۱)، سونش می شود (مرحله چهارم). آخرین و مهمترین مرحله در ساخت سوئیچ، معلق سازی است. در این مرحله فوتورزسیست لایه قربانی برداشته شده و پل بصورت معلق روی خط مرکزی موجبر هم صفحه قرار می گیرد. برای این منظور ابتدا نمونه‌ها در محلول استون قرار داده شده تا فوتورزسیست لایه قربانی برداشته شود. سپس نمونه‌ها در ظرفی حاوی ایزوپروپانول (IPA) به مدت ۵ دقیقه قرار گرفته تا ایزوپروپانول جایگزین استون در زیر لایه پل معلق گردد. سپس، نمونه‌ها در ظرف تری بوتانول مایع ( $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ ) گذاشته می شوند. تری بوتانول ماده‌ای است که در دمای زیر  $20^\circ\text{C}$  جامد بوده و در دمای  $23-25^\circ\text{C}$  ذوب می شود. نمونه‌ها از داخل محلول بیرون آورده شده، بطوری که روی آن‌ها هنوز بوتانول مایع وجود دارد. با پایین آوردن دمای نمونه‌ها، بوتانول جامد شده و نمونه‌ها بسرعت در اتاقک خلاء قرار داده می شوند؛ در اینصورت بوتانول یخ زده در زیر لایه پل معلق، تصعید شده و پل معلق آزاد می گردد (مرحله پنجم). تصاویر گرفته شده توسط میکروسکوپ از مراحل فوق، در جدول (۴) آورده شده است.

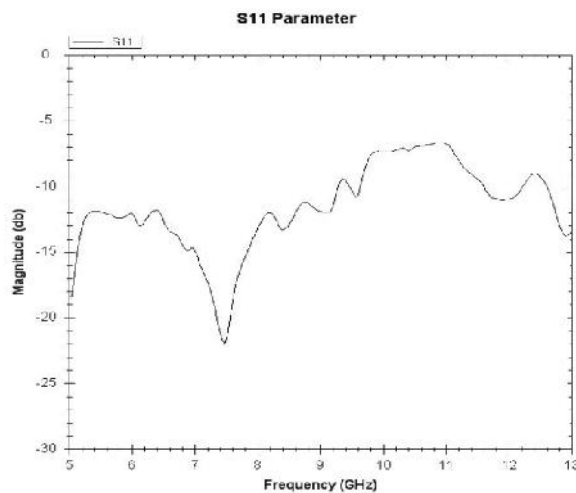


۲- لایه‌نشانی، لیتوگرافی و سونش لایه  $\text{SiO}_2$  دی الکتریک

۱- لایه‌نشانی، لیتوگرافی و سونش لایه طلای موجبر هم صفحه



شکل (۱۴): تلفات داخلی سوئیچ مورد نظر



شکل (۱۵): تلفات بازگشتی سوئیچ مورد نظر

RF MEMS موازی بروی موجبر هم‌صفحه طراحی و ابعاد هندسی آن بدست آمده است. تحلیل و شبیه‌سازی الکترواستاتیکی و گذرای سوئیچ با استفاده از نرم‌افزار CoventorWare و بکارگیری روش المان محدود انجام شد، که ولتاژ پایین‌کننده حدود ۱۹/۲۵ ولت حاصل شده است. در ادامه، تحلیل موجی سوئیچ در دو وضعیت روشن و خاموش با استفاده از نرم‌افزار HFSS و بکارگیری روش المان محدود انجام شده که نتیجه شبیه‌سازی در حالت روشن، نشان می‌دهد که سوئیچ عملکرد خوبی در باند فرکانسی ۴۰-۶۰ GHz دارد و تلفات داخلی در این باند حدود ۰/۸dB و تلفات بازگشتی نیز کمتر از ۹/۸dB است. سوئیچ در حالت خاموش نیز شبیه‌سازی شده، که نتیجه آن بیانگر عملکرد بسیار مناسب سوئیچ در حالت خاموش در این باند است، بطوریکه در این باند مقدار ایزولاسیون مناسب ۵۰dB و تلفات بازگشتی بسیار ناچیز حاصل شده است. با توجه به طراحی انجام گرفته، نمونه آزمایشگاهی سوئیچ RF

پس از پایان مراحل ساخت، بمنظور بدست آوردن مشخصات عملکردی سوئیچ، در حد امکانات موجود اندازه‌گیری‌هایی توسط تحلیلگر شبکه hp در رنج فرکانسی ۵-۱۳GHz صورت گرفت. به دلیل در دسترس نبودن پروب‌های مخصوص اندازه‌گیری‌های موجبر هم‌صفحه (پروب‌های G/S/G)، و بمنظور اندازه‌گیری مشخصات RF سوئیچ، از روش پیشنهادی نشان داده شده در شکل (۱۱) همراه با کانکتورهای SMA با امپدانس مشخصه  $50\Omega$  استفاده شد.



شکل (۱۳): روش پیشنهادی برای اندازه‌گیری پارامترهای سوئیچ

در این روش خطوط موجبر هم‌صفحه توسط نرم‌افزار HFSS بگونه‌ای طراحی شدند که در دو طرف نمونه دارای تطبیق امپدانس  $50\Omega$  باشند. سپس کانکتورها توسط چسب نقره و فیکسچر طراحی شده به موجبر هم‌صفحه متصل شدند. این روش ایده‌آل نیست، چراکه مقاومت خط زمین اتصالات، حدود  $1/5\Omega$  بوده که مقدار قابل ملاحظه‌ای است.

نتایج اندازه‌گیری‌های انجام شده توسط این روش در شکل-های (۱۲) و (۱۳) آورده شده است. دیده می‌شود تلفات داخلی ( $S_{21}$ ) حدود  $-2/5dB$  و مقدار تلفات بازگشتی ( $S_{11}$ ) نیز بیشتر از  $-10dB$  در رنج فرکانسی ۵-۱۳GHz است.

## ۵- نتیجه گیری

در این مقاله یک موجبر هم‌صفحه با امپدانس مشخصه  $50\Omega$  با استفاده از نرم‌افزار HFSS طراحی گردیده است. سپس یک سوئیچ

MEMS ساخته و مورد آزمایش قرار گرفته است، که مقدار تلفات داخلی ۲/۵dB و تلفات بازگشتی بیشتر از ۱۰dB حاصل شده است.

## مراجع

- [1] Rebeiz G.M., Muldavin J.B., RF MEMS switches and switch circuits, IEEE Microwave Magazine, pp.5-71, 2001.
- [2] Katehi, L. P. B., Harvey, J. F. and Brown, E., "MEMS and micromachined circuits for High-Frequency application." IEEE MTT, Vol. 50, No. 3, PP. 858-866, 2002.
- [3] Qian, J. Y., Li, G. P. and De Flaviis, F., "A parametric model of MEMS capacitive switch operating at microwave frequencies." IEEE Int. Microwave Symp. Digest, Vol.2, PP. 1229-1232, 2000
- [4] Muldavin, J. B. and Rebeiz, G. M., "High-Isolation CPW MEMS Shunt Switches Part 1: Modeling." IEEE MTT, Vol. 48, No. 6, PP. 1045-1052, 2000.
- [5] Vijay K. Varadan, K.J. Vinoy, K.A. Jose, RF MEMS and their applications, John Wiley & Sons, INC, 2003.
- [6] Guo F.M., Zhu Z.Q., Long Y.F., Wang W.M., Zhu S.Z., Lai Z.S., Li N., Yang G.Q., Lu W., "Study on low voltage actuated MEMS rf capacitive switches", Sensors and Actuators, Vol. 108, PP. 128-133, 2003.
- [7] Ai-Qun Liu, RF MEMS Switches and Integrated Switching circuits Design, Fabrtrication, and Test, Springer, 2010.
- [8] Mafinejad Y., Kouzani A.Z., Mafinezhad K., "Design and Simulation of a RF MEMS Shunt Switch for Ka and V Bands and the Impact of Varying Its Geometrical Parameters.", IEEE Int. Midwest Symp. On circuits and systems, Vol.12, PP. 823-826, 2009.
- [9] Yunhong Wu, Harold S. Gamble, B. Mervyn Armstrong, "SiO Interface Layer Effects on Microwave Loss of High-Resistivity CPW Line", IEEE Microwave and Guided Wave Letters, Vol. 9, No. 1, PP. 10-12, 1999.
- [10] Gabriel M. Rebeiz, RF MEMS: Theory, Design, and Technology, John Wiley & Sons, INC, 2003.
- [11] Simons, R. N., Coplanar waveguide circuits, component and systems., John Wiley & Sons, INC, 2001.
- [12] Nguyen, C., Analysis methods for RF, microwave, and millimeter-wave planar transmission line Structures. John Wiley & Sons, INC. , 2002.
- [13] Goldsmith C. L., Yao Z., Eshelman S., Denniston D., "Performance of Low-Loss RF MEMS Capacitive Switches.", IEEE Microwave and Guided Wave Letters Vol.8, NO.8, PP. 269-271, 1998.

<sup>1</sup> Coplanar Waveguide

<sup>2</sup> Skin depth

<sup>3</sup> Pull-in voltage

<sup>4</sup> Pull-in voltage